

กนกนันท์ สารสมักร : ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทัลปีของเฟสที่แตกต่างกันในตัวแทน  
สารกึ่งตัวนำแบบเวิร์ตไซต์: การคำนวณแบบแอบ อินิซิโอ (ENTHALPY RELATIONS  
BETWEEN DIFFERENT PHASES IN REPRESENTATIVE WURTZITE  
SEMICONDUCTORS: *AB INITIO* CALCULATIONS)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิ้มปิงานงค์, 180 หน้า.

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้มีการศึกษาคุณสมบัติเชิงกลบางอย่างของ SiC GaN InN ZnO และ CdSe โดยวิธีคำนวณแบบแอบ อินิซิโอ ภายใต้สภาวะปกติ พบว่า สารเหล่านี้มีโครงสร้างผลึกแบบเวิร์ตไซต์ ภายใต้สภาวะความดันสูงสารเหล่านี้สามารถเปลี่ยนโครงสร้างผลึกไปเป็นโครงสร้างผลึกแบบรอกซอลต์ได้ และได้คำนวณค่าความดันสมดุลสำหรับการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกของสารประกอบเหล่านี้ นอกจากนั้นแล้วความเค้นแบบแกนเดียวยังสามารถทำให้ผลึกเวิร์ตไซต์ เปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นผลึกเวิร์ตไซต์ที่มีระนาบผลึกไม่โค้งงอได้ โดยพบว่าความเค้นที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวคือความเค้นกดแบบแกนเดียวยตามทิศทาง [0001] และความเค้นดึงแบบแกนเดียวยตามทิศทาง [01  $\bar{1}$ 0] ซึ่งได้คำนวณค่าความเค้นวิกฤติสำหรับกรณีต่าง ๆ ไว้ด้วยแล้ว นอกจากนั้นยังพบอีกว่าความเค้นดึงแบบแกนเดียวยตามทิศทาง [0001] สามารถทำให้ ZnO เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกไปเป็นผลึกแบบเตตระ โกนอลที่มีอะตอมอยู่ตรงกลาง (BCT-4) ซึ่งเป็นโครงสร้างใหม่ที่ยังไม่เคยมีการรายงานมาก่อนสำหรับ ZnO ความดันสมดุลหรือความเค้นสมดุลในการเปลี่ยนโครงสร้างที่คำนวณได้นี้สอดคล้องเป็นอย่างดีกับผลจากการคำนวณและการทดลองที่มีมาในอดีต ความเสถียรของแต่ละโครงสร้างนั้นศึกษาได้จากการวิเคราะห์ค่าเอนทัลปีเป็นฟังก์ชันของตัวแปรโครงสร้างผลึก  $c/a$  และ  $b/a$  ท้ายสุดยังมีการศึกษาพฤติกรรมของค่าคงที่ยืดหยุ่นที่เป็นฟังก์ชันของความดันของสารที่กล่าวข้างต้น โดยได้พบความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกจากแบบเวิร์ตไซต์ไปเป็นแบบรอกซอลต์ด้วย

สาขาวิชาฟิสิกส์  
ปีการศึกษา 2551

ลายมือชื่อนักศึกษา \_\_\_\_\_  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา \_\_\_\_\_  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม \_\_\_\_\_

KANOKNAN SARASAMAK : ENTHALPY RELATIONS BETWEEN  
DIFFERENT PHASES IN REPRESENTATIVE WURTZITE  
SEMICONDUCTORS: *AB INITIO* CALCULATIONS. THESIS ADVISOR :  
PROF. SUKIT LIMPIJUMNONG, Ph.D. 180 PP.

ENTHALPY/WURTZITE/SEMICONDUCTORS/*AB INITIO*

In this thesis, some mechanical properties of SiC, GaN, InN, ZnO, and CdSe are studied using *ab initio* calculations method. Under ambient conditions, these compounds have the wurtzite (WZ) structure. Under large hydrostatic pressure, the transformation into the rocksalt (RS) structure can take place. The equilibrium transformation pressures are calculated. Moreover, uniaxial stresses can cause the transformation into an unbuckled wurtzite structure (HX) under uniaxial compressive stress along the [0001] crystalline direction or uniaxial tensile stress along the  $[0\bar{1}10]$  crystalline direction and the critical stresses are calculated. In addition, the novel structure, a body centered tetragonal (BCT-4) structure was predicted for ZnO under uniaxial tensile stress along [0001] direction. The predicted equilibrium transformation pressures and stresses are in good agreement with available theoretical and experimental results. The stability of each crystal structure is studied by analyzing enthalpy as a function of lattice parameters  $c/a$  and  $b/a$ . The behavior of the elastic constants as a function of pressure, which related to the WZ-to-RS phase transformation, is also studied for above compounds.

School of Physics

Student's Signature \_\_\_\_\_

Academic Year 2008

Advisor's Signature \_\_\_\_\_

Co-advisor's Signature \_\_\_\_\_